

Pressemitteilung

5/2010



innovations
for high
performance

microelectronics

„Vater“ der IHP-Technologie, Nobelpreisträger Prof. Zhores I. Alferov, besucht Frankfurter Forschungsinstitut Vortrag zur „Halbleiterrevolution im 20. Jahrhundert“

Frankfurt (Oder), 8. Februar 2010: Der weltbekannte russische Physiker und Nobelpreisträger Prof. Zhores I. Alferov wird am 10. Februar 2010 das IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) besuchen. Er gilt als „Vater“ der am IHP entwickelten Technologie für Hochfrequenzschaltkreise, mit der sich das Institut einen internationalen Spitzenplatz im Bereich der Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen für die drahtlose und Breitbandkommunikation erarbeitet hat.

Nach einem Institutsrundgang wird Prof. Alferov vor Mitarbeitern und Gästen des IHP um 14:00 Uhr einen Vortrag zum Thema „Semiconductor Revolution in the 20th Century (Die Halbleiterrevolution im 20. Jahrhundert)“ halten. Anschließend, gegen 15:00 Uhr, steht er gemeinsam mit dem Wissenschaftlich-Technischen Geschäftsführer des IHP, Prof. Dr. Wolfgang Mehr, den Journalisten im Rahmen eines Pressegesprächs für Fragen zur Verfügung.

Prof. Alferov wurde im Jahr 2000 zusammen mit dem Deutschen Herbert Kroemer mit der Hälfte des Nobelpreises für Physik für die Entwicklung von Halbleiterheterostrukturen für Hochgeschwindigkeits- und Optoelektronik – Basis der modernen Informationstechnologie – ausgezeichnet; die andere Hälfte ging an den US-Amerikaner Jack Kilby für die Entwicklung integrierter Schaltkreise.

Pressevertreter sind auch zum Institutsrundgang ab 13:00 Uhr und zum Fachvortrag herzlich eingeladen.

Zur Person: Nobelpreisträger Prof. Zhores I. Alferov

geb. 15. März 1930 in Witebsk (heute Weißrussland)
Studium am Elektrotechnischen Institut in Leningrad (heute St. Petersburg)
1987 bis 2003 Direktor des „Physikalisch-Technischen Instituts A. F. Joffe“ St. Petersburg
bis 2006 wissenschaftlicher Leiter des „Physikalisch-Technischen Instituts A. F. Joffe“
seit 1989 Vizepräsident der Russischen Akademie der Wissenschaften
seit 1995 Mitglied des Parlaments der Russischen Föderation (Duma) und derzeit ihr Alterspräsident
2000 Nobelpreis für Physik
2001 Kyoto-Preis für Verdienste um Wissenschaft und Kultur
2005 Global Energy International Price für besondere Leistungen auf den Gebieten der Energietechnik und Energiewirtschaft

Weitere Informationen:

Heidrun Förster
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit
IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Tel: 0335 5625 204
Handy: 0173 2425 927
Fax: 0335 5625 222
Email: foerster@ihp-microelectronics.com

Über das IHP:

Das IHP ist ein öffentlich finanziertes Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen sowie Höchstfrequenz-Schaltungen und Technologien für die drahtlose und Breitbandkommunikation. Seine Kernkompetenzen sind Materialforschung, Technologieentwicklung, Schaltkreis- und System-Design. Es beschäftigt ca. 280 FuE-Spezialisten und verfügt über eine hochmoderne Pilotlinie für die Herstellung von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen, die sich in einem 1000 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet.